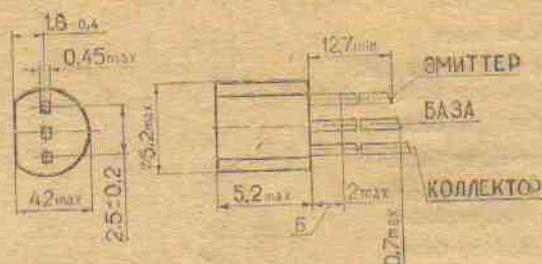




ЭТИКЕТКА

Транзисторы р-р типов:
КТ203АМ, КТ203БМ, КТ203ВМ

Соответствуют ГОСТ 11636-70
и техническим условиям 0.336.001 ТУ



1. Размер выводов в зоне Б не контролируется.
 2. Форма выводов не регламентируется.
 3. Размер $2,5 \pm 0,2$ мм гарантируется на расстоянии 3 мм *max* от корпуса.
- Масса — не более 0,3 г

Содержание драгметаллов в одном транзисторе:
золото 1,1570 мг
палладий 0,0027 мг

Покрyтия выводов драгметаллов не содержат

Обозначение типа транзистора, месяца и года выпуска — цветными метками на плоской поверхности корпуса, кодом согласно табл. 1.

Верхняя метка обозначает тип транзистора, средняя — месяц выпуска, нижняя — год выпуска.

Обозначение группы транзистора — цветной меткой на торцевой поверхности корпуса, кодом согласно табл. 1.

Допускается маркировка транзисторов согласно табл. 1а.

Таблица 1а

Обозначение типа транзистора		Обозначение группы транзистора	
Тип транзистора	Цвет маркировочной метки на боковой поверхности корпуса	Группа транзистора	Цвет маркировочной метки на торце корпуса
КТ203	красный	АМ	темно-красный
		БМ	желтый
		ВМ	темно-зеленый

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ $t_{amb} = +25 \pm 10^\circ C$

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обознач.	Норма		
		КТ203АМ	КТ203БМ	КТ203ВМ
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при: $I_C = 20 \text{ мА}$, $U_B = 4 \text{ В}$, не более	$U_{CE sat}$		1	0,5
Обратный ток коллектора при: $U_{CB} = 60 \text{ В}$, $\mu\text{А}$, не более	I_{CBO}	1		
$U_{CB} = 30 \text{ В}$, $\mu\text{А}$, не более	I_{CBO}		1	
$U_{CB} = 15 \text{ В}$, $\mu\text{А}$, не более	I_{CBO}			1
Обратный ток эмиттера при: $U_{EB} = 30 \text{ В}$, $\mu\text{А}$, не более	I_{EBO}	1		
$U_{EB} = 15 \text{ В}$, $\mu\text{А}$, не более	I_{EBO}		1	
$U_{EB} = 10 \text{ В}$, $\mu\text{А}$, не более	I_{EBO}			1
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при: $I_E = 1 \text{ мА}$, $U_{CB} = 5 \text{ В}$, $f = 1 \text{ кГц}$ не менее	h_{21e}	9		
в пределах	h_{21e}		30-150	30-200
Предельная частота коэффициента передачи тока при: $I_E = 1 \text{ мА}$, $U_{CB} = 5 \text{ В}$, $MГц$, не менее	$f_{h_{21}}$	5	5	5
Емкость коллекторного перехода при $U_{CB} = 5 \text{ В}$, $f = 10 \text{ МГц}$, $\mu\text{Ф}$, не более	C_c	10	10	10
Входное сопротивление в режиме малого сигнала при: $I_E = 1 \text{ мА}$, $f = 1 \text{ кГц}$, $U_{CB} = 50 \text{ В}$, Ом , не более	$h_{11в}$	300		
$U_{CB} = 30 \text{ В}$, Ом , не более	$h_{11в}$		300	
$U_{CB} = 15 \text{ В}$, Ом , не более	$h_{11в}$			300